Проект представляет собой описание полностью пассивного оптического ИИ-акселератора со сверхвысокой плотностью вычислений (пиковая производительность до 40 PetaFLOPS на частоте 100 ГГц), реализованный в виде монолитного планарного кристалла на базе арсенида галлия (GaAs).
Уникальность предлагаемой архитектуры заключается в ПОЛНОМ ОТКАЗЕ от кремниевой транзисторной логики, что делает еѐ потенциально важной для преодоления технологической блокады РФ со стороны недружественных государств.

Архитектура СПЕЦИАЛЬНО спроектирована под микронные и субмикронные проектные нормы. Для еѐ полной реализации достаточно имеющегося в РФ литографического оборудования с допусками 350 нм или 180 нм (0.18 мкм). Проект не требует закупки дефицитного зарубежного нанолитографического оборудования (EUV / DUV уровня 3-нм – 28-нм). Все базовые операции (молекулярно-пучковая эпитаксия соединений А3В5, высокодозовая протонная имплантация и магнетронное напыление золотых СВЧ-шин) полностью соответствуют текущему технологическому укладу отечественной СВЧ-промышленности.